2SC1626

シリコンNPNエピタキシアル形トランジスタ(PCT方式
SILICON NPN EPITAXIAL TRANSISTOR (PCT PROCESS

○ 中電力増幅用

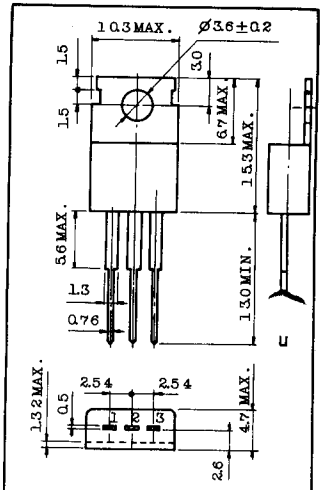
○ 励振段増幅用

∘ Medium Power Amplifier Applications

∘ Driver Stage Amplifier Applications

- 高耐圧です： V_{CEO} = 80V
- 高出力Hi-Fi Amp の励振段に適します。
- 2SA816 のコンプリメンタリになります。
- Complementary to 2SA816

Unit in mm



1. BASE
2. COLLECTOR (HEAT SINK)
3. EMITTER

JEDEC	TO-220AB
EIAJ	SC-45
TOSHIBA	2-10A1A

アクセサリはAC75を適用
MOUNTING KIT No.AC75

最大定格　MAXIMUM RATINGS　(Ta = 25℃)

CHARACTERISTIC	SYMBOL	RATING	UNIT
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	80	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	80	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	5	V
コレクタ電流	I_C	750	mA
エミッタ電流	I_E	−750	mA
コレクタ損失	P_C	1.5	W
接合　温度	T_j	150	℃
保存温度	T_{stg}	−55～150	℃

※ ＰＣＴ技術により製造されています。
Produced by Perfect Crystal Device Technology.

電気的特性　ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta = 25℃)

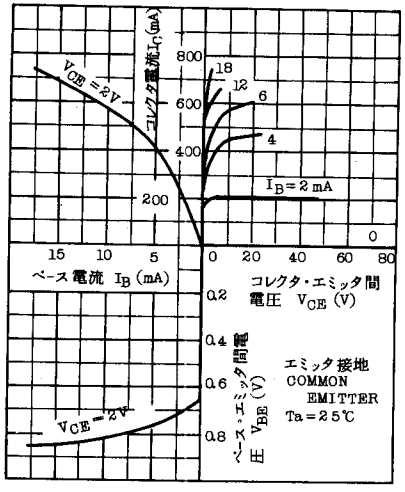
CHARACTERISTIC	SYMBOL	CONDITION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
コレクタしゃ断電流	I_{CBO}	$V_{CB}=30V$, $I_E=0$	–	–	0.5	μA
エミッタしゃ断電流	I_{EBO}	$V_{EB}=5V$, $I_C=0$	–	–	1.0	μA
コレクタ・エミッタ間降伏電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C=10mA$, $I_B=0$	80	–	–	V
エミッタ・ベース間降伏電圧	$V_{(BR)EBO}$	$I_E=0.1mA$, $I_C=0$	5	–	–	V
直流電流増幅率	$h_{FE(1)}$ (Note)	$V_{CE}=2V$, $I_C=150mA$	70	–	240	
	$h_{FE(2)}$	$V_{CE}=2V$, $I_C=500mA$	40	–	–	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=500mA$, $I_B=50mA$	–	–	0.5	V
ベース・エミッタ間電圧	V_{BE}	$V_{CE}=2V$, $I_C=500mA$	–	–	1.0	V
トランジション周波数	f_T	$V_{CE}=2V$, $I_C=150mA$	50	100	–	MHz
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CB}=10V$, $I_E=0$ f = 1MHz	–	15	–	pF

Note　$h_{FE(1)}$ により下表のように分類し，現品表示してあります。

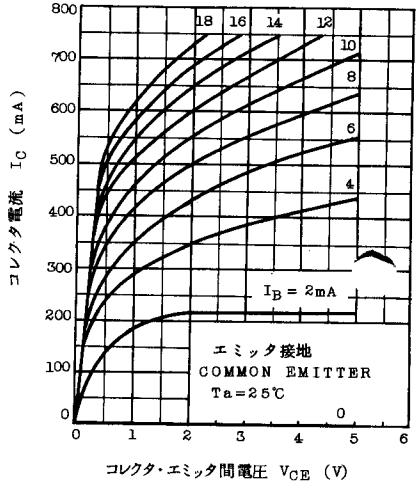
According to the value of $h_{FE(1)}$, the 2SC1626 is classified as follows.

CLASSIFICATION	MIN.	MAX.
2SC1626-O	70	140
2SC1626-Y	120	240

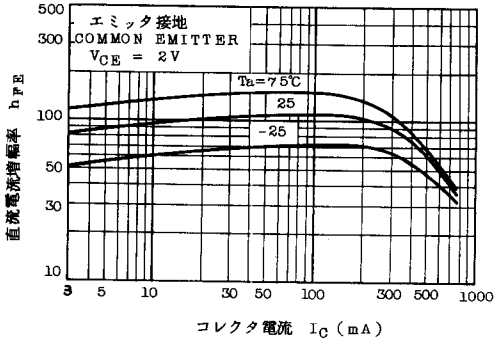
STATIC CHARACTERISTICS



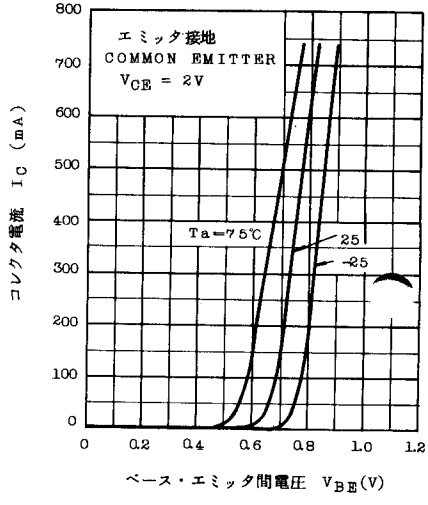
I_C-V_{CE} (LOW CURRENT REGION)



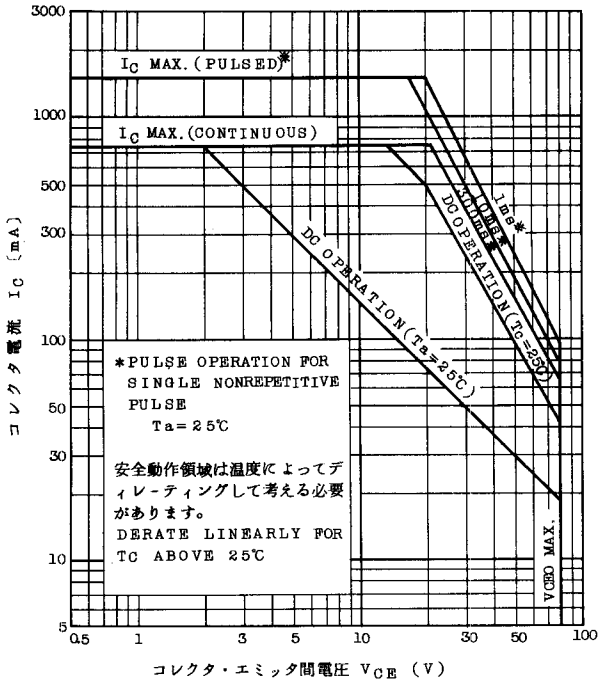
h_{FE} — I_C



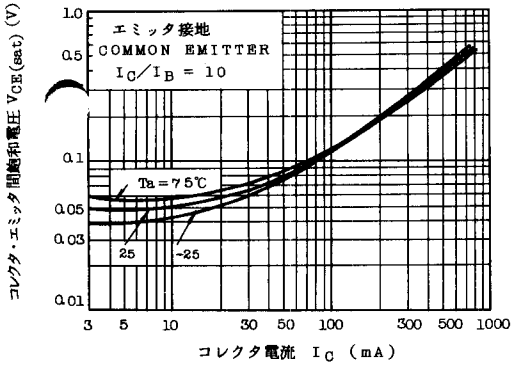
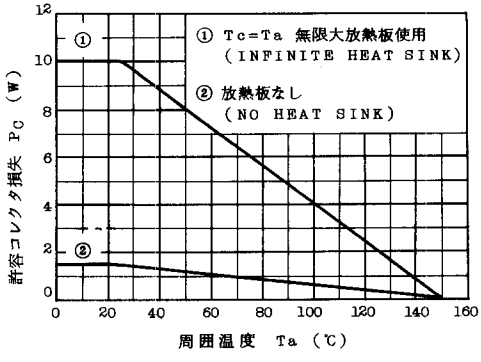
I_C — V_{BE}



安全動作領域　ASO



VCE(sat) —IC



PC — Ta